



Rechercher par mot-clé ou référence





[Home](#) < [Semi-conducteurs](#) < [Composants discrets](#) < [Transistors MOSFET](#)

MOSFET onsemi canal P , TO-220AB 2,7 A 500 V, 3 broches



[Voir la catégorie](#)

En stock à partir du 04/02/2022, pour livraison dès le lendemain


  Unité

Commander

Prix pour l'unité (par multiple de 5)

1,612 €

HT



Un expert passionné est disponible pour vous aider.

Posez-moi votre question

1,934 €
TTC

Unité	Prix par unité	le paquet*
5 - 20	1,612 €	8,06 €
25 - 95	1,356 €	6,78 €
100 - 245	1,102 €	5,51 €
250 - 495	1,026 €	5,13 €
500 +	0,95 €	4,75 €
*Prix donné à titre indicatif		

Options de conditionnement :

☒ Conditionnement standard ☐ Conditionnement industriel standard

Code commande RS: **671-5118** | Référence fabricant: **FQP3P50** | Marque: **onsemi**

[Déclaration de conformité RoHS](#)

[Déclaration de conformité](#)

Documentation technique

[FQP3P50, P-Channel QFET MOSFET 500V -2.7A, 4.9 Ohm](#)

[Schematic Symbol & PCB Footprint](#)

Détail produit

Transistor MOSFET à canal P QFET®, Fairchild Semiconductor

Les nouveaux transistors MOSFET planaires QFET® de Fairchild Semiconductor utilisent une technologie propriétaire avancée pour offrir de meilleures performances d'exploitation pour une large gamme d'applications : alimentations, correction de facteur de puissance, convertisseurs c.c./c.c., écrans plasma, ballasts d'éclairage et contrôle de mouvement.

Ils offrent une réduction des pertes à l'état passant en abaissant la résistance à l'état passant (RDS(on), et une perte de commutation réduite en abaissant la charge de grille (Qg) et la capacité de sortie (Coss). En utilisant la technologie du processus de pointe QFET®, Fairchild peut offrir un meilleur facteur de mérite que les dispositifs planaires concurrents.

Transistors MOSFET, ON Semi

On Semi offre une gamme substantielle de dispositifs MOSFET qui inclut les types haute tension (250 V) et basse tension (250 V). La technologie de pointe au silicium permet une taille de composant plus réduite. Elle est intégrée à plusieurs normes de l'industrie et dans des formats thermiquement améliorés.

×

Un expert passionné est disponible pour vous aider.

Posez-moi votre question

Les transistors MOSFET semi-conducteurs fournissent une fiabilité de conception supérieure, des pointes de tension et des dépassements de tension réduits, pour réduire la capacité de jonction et la charge de récupération inverse, pour éliminer les composants externes supplémentaires pour maintenir les systèmes en service plus longtemps.

Caractéristiques techniques ▼

Attribut	Valeur
Type de canal	P
Courant continu de Drain maximum	2,7 A
Tension Drain Source maximum	500 V
Type de boîtier	TO-220AB
Type de montage	Traversant
Nombre de broches	3
Résistance Drain Source maximum	4,9 Ω
Mode de canal	Enrichissement
Tension de seuil minimale de la grille	3V
Dissipation de puissance maximum	85 W
Configuration du transistor	Simple
Tension Grille Source maximum	-30 V, +30 V
Matériau du transistor	Si
Nombre d'éléments par circuit	1
Température d'utilisation maximum	+150 °C
Longueur	10.1mm
Largeur	4.7mm
Charge de Grille type @ Vgs	18 nC @ 10 V
Série	QFET
Hauteur	9.4mm
Température de fonctionnement minimum	-55 °C



Un expert passionné est disponible pour vous aider.

Posez-moi votre question